

半 导 体 学 报

第 7 卷 第 1 期 1986 年 1 月

目 录

ZnS _x Se _{1-x} 单晶的生长和束缚激子谱线的识别	黄锡珉 (1)
MOSFET 反型层二维电子气 (2DEG) 带尾区域的复值电容	赵冷柱 (10)
多晶硅晶粒度的 X 光衍射增宽傅里叶分析	
.....林振金 刘立竹 龚德纯 来永春 王世润	(18)
MOS 模拟集成电路的噪声分析和低噪声设计	王国裕 南德恒 (24)
半导体薄片少子寿命和表面复合速度的计算方法	王宗欣 褚幼令 (33)
Ag 在 Si(111) 面上吸附的理论研究	车静光 张开明 谢希德 (42)
III、V 族杂质对硅中热施主性质的影响	高小平 周 洁 许振嘉 (48)
GaAs 中碳的红外吸收及其室温浓度测量	
.....江德生 宋春英 郑捷飞 许振嘉	(59)
用低能电子衍射研究小面结构——在 III-V 族化合物半导体表面的应用	
.....陈 平 侯晓远 丁训民 董国胜 杨 曙 王 迅	(65)
用静态升华法制备 CdSe 单晶及其性质的观测	孔宏志 石伟东 王德昌 (73)
中子辐照氢气区熔硅单晶退火行为的正电子湮没研究	熊兴民 (78)

研 究 简 报

硅中铂能级的 DLTS 研究	游志朴 龚 敏 陈继镛 崔新强 (85)
n 型砷化镓中 1.36eV 发光峰的研究	
.....张丽珠 林昭炯 许惠英 秦国刚 王永鸿	(89)
紫外灵敏的表面型硅光电探测器	张苑岳 (95)
液相外延空白区现象的观察	周伯骏 (99)
非晶硅膜爆发结晶中的螺旋线形成机理	陈治明 (102)
可望实用的 Si(113) 晶面	邢益荣 (106)

研 究 快 报

中子辐照氢气生长区熔硅中一个新的三斜对称缺陷	
.....吴 恩 吴书祥 毛晋昌 秦国刚	(109)